# (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭59—194393

⑤Int. Cl.³H 05 B 33/14// C 09 K 11/06

識別記号

庁内整理番号 7254-3K 7215-4H 砂公開 昭和59年(1984)11月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 12 頁)

図改良された電力転換効率をもつ有機エレクト ロルミネツセント装置

②特 願 昭59-58088

②出 願 昭59(1984) 3 月26日

優先権主張 @1983年3月25日 3 米国(US)

**3)478938** 

⑦発 明 者 スチーブン・アーランド・パン スリク

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14613ロチエスター市ピアーポ

ント・ストリート324

⑩発 明 者 チヤン・ウオン・タン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14626ロチエスター市パーモン ト・ドライブ197

⑪出 願 人 イーストマン・コダツク・カン パニー

> アメリカ合衆国ニューヨーク州 14650ロチェスター市ステート

ストリート343

⑩代 理 人 弁理士 湯浅恭三 外4名

明細 智

1. [発明の名称]

改良された電力転換効率をもつ有機エレク トロルミオッセント接置

2. [ 特許請求の範囲 ]

順次陽極、正孔インジェクション帯域、有機 発光帯域(これらの帯域を合わせた厚さは 1μm を越えない)、および陰極からなり、

少なくとも9×10<sup>5</sup>W/W の電力転換効率を もつエレクトロルミネツセント装置。

3. [発明の詳細な説明]

本発明は、有機化合物を発光手段とする、 虚 気信号に応答して発光するエレクトロルミネン セント接続に関する。

有機エレクトロルミネッセント接位がそれらの対抗品と十分に対抗しりるものとなるためには、対抗しりるコストにおいてそれらの低力転

駆動電圧を 2 5 ポルト以下に低下させるため には薄膜型エレクトロルミネッセント 装置が望ましい。 これはとこでは有効な帯域または暫の 厚さ、 すなわち電極間にある物質の厚さが 1μm を毬えない装置を意味する。 ピンホールの問題 を考えると薄膜の形態を達成することは特に困 離であった。 ピンホールは 電池をショートさせ

るので受入れられない。たとえばドレスナー・ RCAレビュー、Vol. 30、322ff 頁 · - (1969年6月)、特に326頁を参照され たい。ピンホールの形成を防止するために、被 獲用配合物中に結合剤を使用することが好都合 とされている。この顔の結合剤の例には付加重 合体たとえばポリスチレン、および縮合重合体 たとえばポリエステルが含まれる。質他のショ - トは避けられるが、結合剤を使用することは 不満足な場合がある。このためには溶剤被緩加 工法を用いる必要があり、ある瘤の쯈削は下層 の溶剤としても作用する可能性があり、これに より衝間の明瞭な境界設定が妨げられる。結合 剤を必要とする1倍を俗剤被覆したのち結合剤 を必要としない階(1階または多層)を蒸磨さ せる方法は考えられるが、逆の順序すなわち発 光順を格削被覆する場合、密削が下槽に影響を 与えた場合の奥用性は証明されていない。

米国特許第4.356.429 身明細能に配載された戦地は、正孔インジエクジョン帝域

わせた厚さは1 um を越えない)、および陰極からなり。

これらの電優のうち少なくとも一方は400 nm 以上の皮慢をもつ輻射線の少なくとも80 まを 透過させることができ、かつ

少なくとも 9 × 1 0 W/W の電力転換効率をも つエレクトロルミネッセント接触が提供される。

(hole injecting zone)としてポルフィリン系化合物からなる樹をもつ本発明のものと同じ型の装備の一例である。

上記特許のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示したが、望まれている電力転換効率、
すなわち25ポルトを越えない駆動電圧を用いた場合に少なくとも9×10°W/Wの水準を選びしていない。正孔インジェクション層内のポルフィリン系化合物は有色であるため、セルにより放出される光を若干吸収するという望ましくない傾向を示す。またポルフィリン系化合物は有効に発光するために必要な正孔および電子の有効な発光的再結合を妨げると思われる。

本発明の目的は、少なくとも 1 桁改良された、 すなわち少なくとも 9 × 1 0 W/W に及ぶ電力 転換効率をもつエレクトロルミネッセント(以 下"EL") 毎度を提供することである。

本発明によれば、順次陽極、正孔インジェクション帯域、有機発光帯域( これらの帯域を含

びる) インジウム製陰徳から構成される。

本発明の装置は必要とされる改良された電力 転換効率を示す。

本発明の接触において発光帯域または正孔インジェクション帯域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達化合物から作取され、これは本発明の実施態様の多くにおいてそれぞれの 帯域に結合剤を用いずに行われる。

本発明のさらに他の有利な特色は、正孔イン ジェクション層用として、 発せられた幅射線に 対し異徴的に透過性である化合物が見出された ことである。

本発明の他の有利な特色は添付の図面を考慮 に入れて後配の好ましい異施慰様を参照することにより明らかになるであろう。 第1図は進頭 に接続した本発明接置の一部の概略的断面図であり。

第2図は本発明に従って製造された毎世に限する 電力転換効率対エレクトロルミネツセント 世子効率を示す対数一対数グラフである。

# 特開昭59-194393(3)

正孔インジェクション物質および発光物質は 各帯域内に存在する(この帯域が層であっても 他のものであっても)。 好ましいエレクトロル ミネンセント 接近においてこれらの物質は順次 重なった被膜ないしは層中に存在する。

本発明の装織に用いられる電子伝導化合物は、酸化環元反応において環元されりる化合物であ

動電圧をかけ、最大電子転換効率または25ポルトのいずれかに選するまで (いずれが先に起 こるとしても)高める。この電圧において最大 EL 電子効率を測定する。

表 | には、上記のように構成され、かつ上記の電圧で駆動される装度において試験した場合の若干の有用な電子伝達化合物に関するEL蟹子効率を示す。とれらの例のそれぞれにつき、最大ELR子効率の電圧は25ポルトの制限以下であった。

る。本発明において特に有用なものは、前記の 試験に関して少なくとも 5×10°E L 量子効率 を与える電子伝達化合物である。周知のように E L 量子効率は単純に外部回路で剛定される電子/秒に対する、セルから放出される光子/秒 の比に等しい。この効率を成力伝換効率(W/W の単位で定義される)と混闹してはならない。

選子伝達化合物が少なくとも 5×10°光子/ 電子( すなわち 0.05%) のEL 量子効率を与 えるか否かを判定するためには下配の試験を行 う。

ELセルは下記の顧序で構成される:
400 nm 以上の波長をもつ輻射線の少なくとも80%を透過させる陽極[たと允ばネザトロン(Nesatron. 商標) ガラス]; 本質的に1,1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル) シクロヘキサンからなる正孔インジェクション層; 問題の選子伝達化合物の層; およびインジウム製陰極。ここで正孔インジェクション層と発光層は合わせて厚さ1 μを越えない。 蝦

過行点に対する	1 8 V	2 0 V	2 0 V	1 5 V	125 V	2 4 V	1 5 V	1 4 V	
——	$\frac{2\times10}{}$	1×10	8×10³	3×10	3×10°	1.5×10°	5×10³	8×10	-
彩	[ [ ]	( 形数色) 1 14-12-26海/HI-1(75nE)/E1 175-17-148	・	// Jum // In函函 扩下750m // E3 / Jun // E88	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1、2mm/1mmg サトロン砂筒/HI-1(75mm/E5	************************************	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

D5を除いて有効餃子 1 個に四拾五入した。

[ 4,4' - ピス [ 5,7 - ジt - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル ] スチルペン]

[2,5-ビス[5,7-ジ-t-ペンチル-2-ペンゾキサゾリル]チオフェン]

[2,2'-(1,4-フェレンジピニレン)ピスペングデアゾール]

# 6 E4=

[ 2,2'-(4,4'-ピフェニレン)ピスペンゾチアゾール]

7 E5= ビス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウム

[ 2,5 - ピス[ 5 - ( α , α - ジメチルペンジル ) - 2 - ペンゾキサゾリル ] チオフェン ]

9 E7=

[2,5-ビス[5,7-ジーt-ベンチル-2-ベンゾキサゾリル]-3,4-ジフェニルチオフエン]

# 特閥昭59-194393(5)

より好ましくは、正孔インジェクション暗は本質的に無色である。これは陽極に隣接した位度にあり、陽極は透明な既優であることが好ましい。従って正孔伝達化合物も400nm 以上の放長において少なくとも90年透過性であることが好ましい。

前記の光透過性をもつ有用な正孔伝達化合物の好ましい例には、室温で間体であり、かつ少なくとも1個の寝器原子が厳機器でトリ散換さ

あるいは他の場合には正孔と選子の発光的再 結合を妨げない結合剤も本発明に有用である。

前記のように薄膜を形成しらる化合物の有用な例を以下に示す。 等に有用な例には複素環もしくは炭素環、および 5 個以上の炭素原子を有する脂肪族鎖少なくとも 2 個を含有するか、あるいは少なくとも 2 個の基すなわちそれぞれ。) 一重結合の出りに回転しらる基および 4) 少なくとも 5 個の芳香族もしくは飽和炭素資を含む 花を含有する化合物が含まれる。

たとえば 神順 形成性である 正孔 伝達 化合物 に は次式の 関連をもつものが含まれる。

れた(そのうち少なくとも1個はアリール基または置換アリール基である)アミンが含まれる。アリール基上の有用な置換器の例には、1~5個の炭素原子をもつアルギル基、たとえばメチル基、エチル基、プロピル基、プチル基およびアミル基;ハロゲン原子、たとえばメトキン基、エトキン基、プロポキン基、プチル基およびアミル基である。

1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン:および次式の構造をもつ 化合物

(上記式中nは2~4の整数である). たとえば4.4- ビス(ジフェニルアミノ)クワドリフ

ェニル。

さらに他の有用な正礼伝達化合物には米国特許第4.175.960号明細皆13個13行から14個42行に列挙されたもの。たとえばビス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)フェニルメタンかよびN.N.N-トリ(p-トリル)アミンが含まれる。

海線形成性の電子伝達化合物に関しては、好ましい例には螢光増白剤が含まれる。最も好ましいものは次式の構造をもつ螢光増白剤である。

R<sup>3</sup>は1~20個の炭素原子を有する鮑和脂肪族 残酷、たとえばメチル基、エチル基かよびn-アイコンル基:6~10個の炭素原子を有する アリール粘、たとえばフェニル基かよびナフチ ル基:カルボキシル基:水器原子;シアノ基; あるいはハロゲン原子、たとえば塩器原子かよ びフッ器原子であり;ただし式c)にかいて R<sup>3</sup>.R<sup>4</sup> および R<sup>3</sup>のりち少なくとも2個は3~ 10個の炭累原子を有する飽和脂肪族改基、たとえばプロピル基、ブチル基またはベプチル基であり、

Zは-O-. -NH-または-S- であり; Yは-R<sup>®</sup>+CH=CH+<sub>n</sub>R<sup>®</sup>-.

mは0~4の整数であり;

nは0,1,2または3であり;

 $R^T$  は水梨原子または6~10個の炭素原子を有するアリール基であり、そしてZ'およびZ'は別個にNまたはCH である。

上記の脂肪族兇基は健煥されていてもよい。健

# 特関昭59-194393(ア)

換された脂肪族改善の場合の健換基には、1~5個の炭素原子を有するアルキル基、たとえばメチル基、エチル基かよびプロピル基:6~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフェニル基かよびナフチル基:ハロゲン原子、たとえば塩α原子かよびフン素原子:ニトロ基:たらびに1~5個の炭α原子を有するアルコキン基、たとえばメトキン基、エトキン基およびプロポキン基が含まれる。

特に好ましい登光増白剤の例には下記のものが含まれる。 2,5 - ピス(5,7 - ジー t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル) - 1,3,4 - チアジアゾール;4,4'-ピス(5,7 - t - ペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル) スチルペン; 2,5 - ピス(5,7 - ジーt - ペンゲキサゾリル) チオフェン; 2,2'-(p - フェニレンジピニレン) - ピスペンゾチアゾール;4,4'-ピス(2 - ペンゾキサゾリル) ピフェニル; 2,5 - ピズ(5 - (α,α - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル]チオフェン; 4,4'-

ピス[5,7 - ジ - (2 - メチル - 2 - ブチル)
- 2 - ベンゾキサゾリル]スチルベン; および
2,5 - ピス[5,7 - ジ - (2 - メチル - 2 - ブ
チル) - 2 - ベンゾキサゾリル] - 3,4 - ジフ
ェニルチオフェン。

さらに他の有用な螢光増白剤はケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ、1971、628~637頁かよび640頁に列挙されている。すでに薄膜形成性ではないものは、一端または両端の環に脂肪族の基を結合させることによって薄膜形成性にすることができる。この種のさらに有用な螢光増白剤には、たとえば下配のものが含まれる。

[2-{2-[4-(2-ベンソイミダゾリル] フェニル ] ピニル ] ベンゾイミダゾール ]

[5-メチル-2-{2-[4-(5-メチル-2-ベンゾキサゾリル)フェニル]ビニル}ベンゾキサゾ-ル]

[ 2,5 - ビス ( 5 - メチル - 2 - ペンゾキサゾ リル)チオフェン]

[2-[2-(4-カルボキシフェニル)ビニル]ベングイミダゾール] シよび

[2-[2-(4-クロルフェニル)ビニル] ナフト[1,2-d]オギサゾール]

さらに他の有用な複膜形成性の電子伝達化合物には8-ヒドロキシキノリンの金属錯体が含まれ、その際金属は好ましくはZn.Al.Mg またはLi である。

有効層の一方が複膜形成性である場合、容易に認められるようにピンホールのため接触がショートすることはないので、他方は薄膜形成性である必要はない。たとえば有用な接触は、前記の複膜形成性化合物からなる正孔インジェクション層、および博膜形成性でない化合物、たとえば1,1,4,4ーテトラフェニルー1,5ープタジェンからなる発光像を含む。

前記の袋 | から明らかなように、有用な陽極 磁缆には簡牒"オザトロン"のもとにPPGイ

ンダストリーズ社から得られる被覆ガラス陽板 が含まれ、有用な陽振電極にはインジウムが含 まれる。一般のいかなる勝億および陰極もそれ が適切な仕事観蚊鰒をもつならは便用できる。 たとえば陽極は高い仕事関数をもつべきである。 他の有用な陽極の例にはいずれかの半透明な高 い仕事関政をもつ導起性材料、たとえば酸化ス ズインジウム、飲化スズ、ニッケルまたは金で 被優したガラスが含まれる。好ましくは、との 1008~1000カーム/スクエアー (ohms/square)のシート抵抗、および400 nm 以上の彼長に対し30%の光透過率をもつ。 このように高い光透過窓を少なくとも90まと いり正孔伝達化合物の透過率と合わせた場合に、 本発明に従って作成された装置の特色である卓 越した魔力転換効率が保証される。

他の有用な陰極の例には低い仕事関数をもつ 他の金属、たとえば銀、スズ、鉛、マクネシウム、マンガンおよびアルミニウムが含まれる。 金属が接置により発生するルミネンセンスに対 して高い透過率をもつか否かは関係ない。

明1図は本発明に従って製造されたエレクトロルミネッセント接置を示す。 これは酸化スズインウムの半透明被膜16で被優されたガラス製支持体14からなる陽低12を含む。この上に正代インジェクション倍18が配置される。 階18かよび20の一方または双方が薄膜形成性化合ったの一方または双方が薄膜形成性化合ったのイヤ24が接触を超源26に接続する。 電の18と20の界面へ伝達され、ここで陰極22から伝達された電子と結合し、可視光線hレを発する。

電源26が接配10の最大出力点の電圧たと えば15~25ポルトで操作される場合、最大 電力転換効率は少なくとも9×10 W/Wであ る。ある場合にはこの効率が2×10 に及ぶこ とが認められた。本発明の接置は改良された電 力転換効率の結果1700cd/π(500フィー

トランベルト)に及ぶ最大輝度を生じることが 認められた。

本発明のEL装蔵は常法により作成される。すなわち正化インジェクション層、発光層をおり び 悠 徳 を それぞれ 密 被 被 優 法 または 蒸 発により 施 す。 正 化 インジェクション 層 が 最 初 に 形 破 び 好 ま しい。 発光 層 に 有 用 女 容 層 が が れることが 好 ま しい。 発光 層 に 対 し て も 良 好 な 容 気 が ま しい。 ここで 明い られる " 蒸 発 "に は 蒸 気 が らの た 瘤 の あ ら ゆ る 形態 が 含 ま れ、 真 空 下 で われる も の も 含まれる。

下記の実施例により本発明をさらに説明する。 これらの実施例において最大輝度は不可逆的破壊を生じる電圧のすぐ下の電圧で側定される。 若干の実施例において駆動電圧について25V といり好ましい限度を越える輝度に関する電圧 が示されているのはこのためである。

## 奥施例1

**第1図のものと類似したエレクトロルミネッ** 

セント袋魔(以下"セル")を以下により製造 した。

- 1) 陽極を作成するため、オザトロンガラスをまず 0.05 μm アルミナの研解材で数分間研磨した、次いでイソプロピルアルコールおよび蒸留水の1:1(V)混合物中で超音波清浄した。次いでこれをイソプロピルアルコールですすぎ、窒累で送風乾燥させた。最後に、使用前にこれをトルエン中で超音波清浄し、窒累で送風乾燥させた
- 2) 1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン(HI-1)をネザトロンガラス上に一般的な真空蒸管法により沈暗させた。すをわち上配物質を選気的に加熱されたクンタル製ポートから320℃の昼度で5×10°トルの系内圧力において蒸発させた。ネザトロンガラスに沈后した生成HI-1フィルムの厚さは75nm であった。
- 3) 次いで 4,4′-ビス ( 5,7 ジ- t ベンチル- 2 ベンゾキサゾリル)スチルベン(E1)

4) 次いでインジウムをE1フィルムの上部に シャド-マスクを介して沈滑させた。 In 監徳 の面徴は D.1 cmであり、これもエレクトロルミ ネッセントセルの有効面徴を規定した。

出来上がったセルはネザトロンガラス電極をプラスとしてバイアスをかけた場合、育緑色の光を放出した。放出された光は520nm に最大放出を有していた。 違成された最大輝暖は与えられた曜田が22Vである場合、 環航密暖140mA/cm において340cd/m であった。20Vで駆動した場合、最大電力転換効率は1.4×10<sup>3</sup>W/W であり、最大エレクトロルミネッセント数子効率は1.2×10<sup>2</sup>光子/電子であった。

## 奥施例2

瘻膜形成性でない正孔インジエクション層の

2 0 ポルトで駆動した場合、梭大電力転換効率 は8.1×10 W/W であり、最大EL電子効 率は6.9×10 光子/な子であった。

とれらの結果は、発光層が薄膜形成性化合物 からなるためピンホールを含まないならば正孔 インジェクション層は薄膜形成性でなくてもよ く、また結合剤を含有しなくてもよいことを証 明している。

## 実施例3

## 発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし下記の螢光増白剤を発光層として明いた。

( 2,5 - ビス ( 5,7 - ジ - t - ベンチル - 2 -ベンゾキサゾリル ) - 1,3,4 - チアジアゾ - ル] 使用

実施例1に記載したようにエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただしN.N.N-トリ(p-トリル)アミンを正孔インシェクション質としてHI-1の代わりに使用した。このアミンは次式の構造をもつ。

セルは実施例1に配取したものと同じ方法で製造された。ただしアミン蒸発のための供給源温度は120℃であった。厚さは75 nm であった。このセルに30 Vをかけた場合、電流密度40 mA/cd および最大輝度102 cd/m が得られた。放出された光はこの場合も守緑色であり、520 nm に最大放出を有していた。

奥施例1と同様にしてセルを製造した。ただし登光増白剤の蒸発のための供給源温度は260でであった。放出された光は橙色であり、590nm に殺大放出を有していた。得られた最大輝度は30Vかよび40mA/cdにおいて340cd/プであった。20Vで駆動された場合、最大電力転換効率は1.5×10<sup>3</sup>W/W であり、最大EL量子効率は1.4×10<sup>3</sup>光子/原子であった。

#### 発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2.2-(p-フェニレンジビニレン)ビスペンゾチアゾール(E3)を発光層として用い、300℃で蒸発させた。

E 3

とのセル (オザトロン/HI-1/E3/In)

# 特開昭 59-194393 (10)

は緑色の光を放出し、これは560nm に最大 放出を有していた。得られた最大輝度は17.5 V かよび200mA/cdにおいて340cd/m で あった。15Vで駆動した場合、最大電力転換 効率は4×10 W/W であり、最大エレクトロ ルミネンセント量子効率は3×10 光子/量子 であった。

#### 契施例5

#### 発光費用の他の物質

前記 医施例 1 と 何様 に して エレクトロルミネッセント セルを 製造した。 ただし 2 - ( 4 - ビフェニル) - 6 - フェニルペンゾキサゾ - ル ( P B B O )を発光値として E 1 の 代わりに 用い、 200℃で蒸発させた。

このセル(オザトロン/HI-1/PBBO/In)は白育色の光を放出した。得られた最大輝曜は25Vおよび50mA/cd において34cd/㎡であった。20Vで駆動した場合、最大電力転換効率は9.5×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセント量子効率は8×10 光子/電子であった。

## 奥施 6 および 7

## 発光層用の他の物質

要施例 1 と同様にしてエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし発光簡は E 1 の代わりに 2,5 - ビス [ 5 - (α,α-ジメチルペンジル) - 2 - ベンゾキサゾリル ] チオフエン ( 実施例 6 ) かよび 2,5 - ビス [ 5,7 - ジー t - ペンチル - 2 - ベンゾキサゾリル ] - 3,4 - ジフェニルチオフェンからなり、340℃の温度で蒸発させた。 袋 』 に 告果を示す。

<b>影</b>	<b>分</b> 略側に 観動 調力	15V	1 4 V
	版 形 田 西 安 安 安 安 安 多 多 多 多 多	5×10 8子/電子	1.4×10 84×10 W/W 位子/电子
	の数はなりを発生を発生	7×10 W/W	1.4×10 W/W
	段輝大度	680cd/m² (19Vかよび 150mA/cm² パなかて)	1700cd/m² (20V&LU 300mA/cd K&NT)
	成故	530 am	•
	<b>4</b> D	碟 .	4
	展 開 国	۰	7

## 奥施例8

# 薄膜形成性でない電子伝達化合物

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし、1,1,4,4 - テトラフェニル-1,3-プタジエン(TPB)を発光層として用いた。

TPB昇華のための供給源温度は210℃であった。このセルは育色の光を放出し、これは450nm に最大放出を有していた。得られた郷度は20V⇒よび200mA/cm にかいて102cd/m であった。15Vで駆動した場合、最大戦力伝験効率は2×10 W/W であり、最大エレクトロルミネンセント 貴子効率は1.2×10 光子/電子であった。このセルは蒸発したTPB

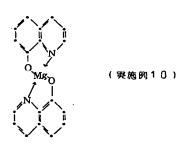
# 特開昭59-194393(11)

層の不均質なかつ薄膜形成性でない性質にもかかわらず機能した。TPB層は顕微鏡下で見た 場合小さなクラスターのモザイクの外観を有し ていた。

**奥施例9 および10** 

電子伝達化合物として8-ヒドロキシキノリノ の金減錯はを使用

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただしビス( 3 - ヒドロキシキノリノ)アルミニウム( 実施例9)、および次式



の構造をもつビス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウムをそれぞれ発光圏として用いた。 操作条件は実施例1の配数と同様であった。ただし金銭鍇本の供給源温度はそれぞれ330℃ (実施例9)および410℃(実施例10)で あった。表』に結果を示す。

	臨軍由	15V	24V
	最 大 也 L 也子効率	5.8×103米子/位子	1.5×10。 光子/盘子
	最大 電力 転換効率 (W/W)	82×10+	1.4×10*
₩X	吸 類 女 東 選 (c q / n;)	340 (15V±LC 50¤A/cd	340 (24V\$LC 100mA/cd (C\$\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi
	数はまなれられる。	515nm	548nm
	放出放されたの状のの一般	袋	蘂
	平	٥	10

上記各実施例に示した効塞を便宜のため第2 図にブロットした。第2図の点線は傾向を示す にすぎず、いずれかの方法による最適なものを 表わすものではない。そこに示されたデータは 娯係式

Pog(成力転換効率)= Pog(ELは子効率)+ Pog K (上記式中Kは切片(intercept) であり、 駆動 選圧によって一部制御される係数である) に従うとほぼ道線状である。駆動選圧(第1図 の監顔26)の値が上がるのに伴って、第2図 の曲線は下方へ移動する。従ってより高い駆動 選上では、同一のELな子効率でも、もはや希 望する9×10 W/W の超力転換効率を与えないようになるであろう。

# 4. [ 図面の簡単な説明 ]

第1図は 関源に接続した本発明 接慮の一部の 観略的 新面図であり、

第2図は本発明接近に関する電力転換効塞対 エレクトロルミネッセント数子効塞を示す対数 - 対数グラフである。 図中の各記号は下記のものを襲わす。

10:エレクトロルミオツセント 英魔;

12:陽極: 14:ガラス製支持体;

16:半透明被膜;

18:正孔インジェクション層; 20:発光層;

22: 悠極; 24:リードワイヤ;

26:超颜。

特 許 出 願 人 イーストマン・コダック・カンパニー

代 理 人 弁理士 湯 没 恭 三 [編] (外4名)

